



XIII Российская конференция по физике полупроводников

Приглашаем Вас принять участие в работе
XIII РОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ФИЗИКЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
Конференция будет проводиться с **25 по 29 сентября 2017 г.**
в **Екатеринбурге**
в Институте физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН

Формат конференции

Программа Конференции включает пленарные заседания и заседания по секциям. Предполагается заслушать несколько пленарных докладов, в том числе выполненных зарубежными учеными, около 30 приглашенных докладов по ключевым разделам программы и около 70 устных сообщений, отобранных Программным комитетом. Также запланированы двухчасовые стендовые сессии.

Сайт конференции <http://semicond2017.imp.uran.ru>
Окончание подачи тезисов **27 марта 2017 г.**

Организаторы конференции

- Научный совет по физике полупроводников РАН
 - Отделение физических наук РАН
 - Федеральное агентство научных организаций РФ
 - ФГБУН Институт физики металлов им. М.Н.Михеева УрО РАН
 - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
- Конференцию поддерживают**
- Федеральное агентство научных организаций
 - Российская академия наук
 - Российский фонд фундаментальных исследований
 - ФГБУН Институт физики металлов им. М.Н.Михеева УрО РАН
 - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Тематика конференции

Конференция посвящена фундаментальным проблемам физики полупроводников.

Основные разделы программы:

1. Объемные полупроводники
2. Поверхность, пленки, слои
3. Гетероструктуры и сверхрешетки
4. Двумерные системы
5. Одномерные и нульмерные системы
6. Спиновые явления, спинтроника, наноматематизм
7. Примеси и дефекты
8. Высокочастотные явления в полупроводниках
9. Органические полупроводники, молекулярные системы
10. Углеродные и графеноподобные наноматериалы
11. Фотонные кристаллы и метаматериалы. Нанофотоника
12. Полупроводниковые приборы и устройства
13. Наномеханика
14. Топологические изоляторы

Программный комитет

- Е.Л. Ивченко, председатель** ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
М.М. Глазов, ученый секретарь ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
- Ж.И. Алферов СПб АУ НОЦНТ РАН, Санкт-Петербург
А.А. Андронов ИФМ РАН, Нижний Новгород
А.Л. Асеев ИФП СО РАН, Новосибирск
В.А. Волков ИРЭ РАН, Москва
С.В. Гапонов ИФМ РАН, Нижний Новгород
А.В. Германенко УрФУ, Екатеринбург
А.А. Гиппиус ФИАН, Москва
А.А. Горбачев ФИАН, Москва
А.В. Двуреченский ИФП СО РАН, Новосибирск
В.С. Днепровский МГУ, Москва
А.Г. Забродский ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
С.В. Зайцев-Зотов ИРЭ РАН, Москва
А.А. Каплянский ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
В.В. Кведер ИФТТ РАН, Черноголовка
П.С. Копьев ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
З.Ф. Красильник ИФМ РАН, Нижний Новгород
Г.Я. Красников ОАО «НИИМЭ и «Микрон», Зеленоград
И.В. Кукушкин ИФТТ РАН, Черноголовка
В.Д. Кулаковский ИФТТ РАН, Черноголовка
Л.В. Кулик ИФТТ РАН, Черноголовка
Ю.Г. Кусраев ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
А.В. Латышев ФП СО РАН, Новосибирск
И.Г. Неизвестный ИФП СО РАН, Новосибирск
В.И. Окулов ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
В.Я. Покровский ИРЭ РАН, Москва
А.А. Саранин ИАПУ ДВО РАН, Владивосток
Н.Н. Сибельдин ФИАН, Москва
Р.А. Сурис ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
А.С. Терехов ИФП СО РАН, Новосибирск
В.Б. Тимофеев ИФТТ РАН, Черноголовка
В.В. Устинов ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
В.М. Устинов ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Д.Р. Хохлов МГУ, Москва
А.В. Чаплик ИФП СО РАН, Новосибирск
В.И. Шашкин ИФМ РАН, Нижний Новгород
М.В. Якунин ИФМ УрО РАН, Екатеринбург

Контакты

620990 Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 18, Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН
Якунин Михаил Викторович, председатель: (343) 3783644
Окулов Всеволод Игоревич, заместитель председателя: (343) 3745253
Гудина Светлана Викторовна, ученый секретарь: (343) 3783788
факс: (343) 3745244 e-mail: semicond2017@imp.uran.ru